

1 Elektrostatik

Coulombsches Gesetz: $\mathbf{F}_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12}$

Elektrisches Feld:

$\mathbf{E}(\mathbf{r}) := \mathbf{F}_C(\mathbf{r})/q, \mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r})$

Elektrische Feldstärke: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$

Superposition: $\mathbf{E}(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{R} - \mathbf{r}}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|^3} \rho(\mathbf{r}) dV$

mit $Q = \int \rho(\mathbf{r}) d^3r$, diskrete Landungsverteilung:

$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i$

Elektrischer Fluss $\phi_E := \int \mathbf{E} d\mathbf{A}$:

$Q_{\text{innen}} = 0 \rightarrow \phi_E = 0$

$Q_{\text{innen}} > 0 \rightarrow \phi_E > 0$ (Quelle)

$Q_{\text{innen}} < 0 \rightarrow \phi_E < 0$ (Senke)

Gaußsches Gesetz: $\oint \mathbf{E} d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\epsilon_0}$

Feld einer Linienladung: $E(r) = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$

Feld einer Flächenladung: $E(r) = \sigma / (2\epsilon_0)$

Innerhalb von Leitern (auch in Hohlräumen):

$\mathbf{E} = 0, Q = 0$

Gaußscher Satz: $\oint_A \mathbf{E} d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV$

Gaußsches Gesetz (differentielle Form): $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$

Potentielle Energie: $E_{\text{pot}}(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}_C d\mathbf{s}$

Coulombpotential (Punktladung): $E_{\text{pot}}(\mathbf{r}) = Qq / (4\pi\epsilon_0 r)$

Zirkulationsgesetz: $\oint \mathbf{E} d\mathbf{s} = 0$

Elektrisches Potential: $\varphi(\mathbf{r}) = \frac{E_{\text{pot}}(\mathbf{r})}{q} = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} d\mathbf{s}$

$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\varphi(\mathbf{r})$

Allgemeine Ladungsverteilung:

$\varphi(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r})}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|} dV$

Elektrische Spannung: $U_{12} = \Delta\varphi_{12} = \varphi_2 - \varphi_1 = - \int_1^2 \mathbf{E} d\mathbf{s}$

Poisson Gleichung: $\Delta\varphi = -\rho/\epsilon_0$

Dipolmoment: $\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$

Dipol: $\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{r} + \mathbf{d}/2|} \right)$

$r \gg d$: $\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Feld für $r \gg d$: $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r} - r^2 \mathbf{p}}{r^5}$

Homogenes Feld: $\mathbf{M} = \mathbf{D} \times \mathbf{F} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$

$E_{\text{pot}} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$

Kugellektroden: $\Delta\varphi = - \int_{\infty}^R \mathbf{E} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$Q = 4\pi\epsilon_0 R U$

Kapazität: $C := Q/U$

Plattenkondensator: $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/A\epsilon_0$

$C = Q/U = \epsilon_0 A/d$

Kugellektroden: $C = 4\pi\epsilon_0 R_2 R_1 / (R_2 - R_1)$

Parallelschaltung: $C_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n C_i$

Reihenschaltung: $1/C_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n (1/C_i)$

Energie gespeichert im Kondensator: $E_C = \frac{1}{2} C U^2$

Plattenkondensator: $E_C = \frac{1}{2} \epsilon_0 V E^2$

Energiedichte: $\omega_C = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

Permittivität ϵ_r : $C_{\text{Diel}} = \epsilon_r C_{\text{Vakuum}} = \epsilon_r C_0$

$E_{\text{Diel}} = \frac{E_{\text{Vak}}}{\epsilon_r}$ Polarisation: $\mathbf{P} = (1/V) \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i$

$\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{Diel}}$ elektrische Suszeptibilität $\chi = \epsilon_r - 1$

Dielektrische Verschiebung: $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{Diel}} + \mathbf{P} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{Diel}} = \epsilon_0 \mathbf{E}_{\text{Vak}}$

1. Maxwellsche Gleichungen in Materie:

$\oint \mathbf{D} d\mathbf{A} = Q_{\text{frei}}$

$\oint \mathbf{E} d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{frei}}}{\epsilon_r \epsilon_0}$

Elektrische Feldenergie: $W_e = Q^2 / (2\epsilon_r C_0)$

Energiedichte: $\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}^2 = \frac{1}{2} \mathbf{E} \mathbf{E}$

2 Elektrische Gleichströme

Elektrischer Strom: $I := dQ/dt$

Elektrische Stromdichte: $|\mathbf{j}| = I/A = dQ/dA dt$

Technische Stromrichtung: Flußrichtung der positiven Ladungsträger!

Ladungsfluß: $U = \varphi_b - \varphi_a = E dl$

Differentieller Widerstand: $r = dU/dI$

Differentielle Leitfähigkeit: $S = dI/dU$

Ohmscher Leiter $\rightarrow r = \text{const.}$

Ohmsches Gesetz: $U = RI$

$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} = n q_e \mathbf{v}_D$

Spezifische Leitfähigkeit: $\sigma = l/RA = S(l/A)$

Spezifische Widerstand: $\rho = 1/\sigma = R(A/l)$

ohmsche Leiter: $\mathbf{v}_D = \mu \mathbf{E}$

Elektronenbeweglichkeit $\mu = q\tau/m$

Mittlere Zeit zwischen zwei Wechselwirkungen: τ

Elektrische Leistung: $P = U \cdot I$

Ohmscher Leiter: $F = RI^2, F = U^2/R$

Kirchhoffsche Regeln:

Knotenregel: An jedem Knoten gilt: $\sum I_k = 0$

Maschenregel: Für jede Masche gilt: $\sum U_k = 0$

Reihenschaltung: $R = \sum_{i=1}^n R_i$

Parallelschaltung: $1/R = \sum_{i=1}^n (1/R_i)$

Spannungsquelle (R_i : Innenwiderstand): $U_{kl} = U_0 - IR_i$

Stromquelle: $R_i \rightarrow \infty$

3 Magnetostatik

H : magnetische Erregung

B : Magnetfeld und magnetische Flussdichte

Magnetischer Kraftfluß: $\phi_m = \int \mathbf{B} d\mathbf{A}$

Lorentzkraft: $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

Leiter: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$

Zyklotronfrequenz: $\omega = (q/w)B$

Leiterschleife: Magnetisches Moment: $\mu = I\mathbf{A} = I\mathbf{A}\mathbf{n}$

Drehmoment auf einen magnetischen Dipol:

$\mathbf{M} = \mu \times \mathbf{B}$

Hallspannung: $U_H = (1/nq)(I/d)B = R_H(I/d)B$

Leiter vekoriell: $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{r}})$

Quellfreiheit: $\oint_A \mathbf{B} d\mathbf{A} = 0$

Ampersches Durchflutungsgesetz: $\oint \mathbf{B} d\mathbf{s} = \mu_0 \sum I_k = \mu_0 I_{\text{innen}}$

Spule: $B = \mu_0 n I$

Biot-Savart-Gesetz:

$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$

$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$

Z-Feld einer Stromschleife: $B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2\pi R^2}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$

Leiterschleife ($r \gg R$): $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(3 \frac{\mu \cdot \mathbf{r}}{r^5} \mathbf{r} - \frac{1}{r^5} \mu \right)$

Magnetisierung: $\mathbf{M} = (1/V) \sum_i \mu_i$

Magnetfeld aufgrund der Magnetisierung M :

$\mathbf{B}_{\text{mag}} = \mu_0 (I_m/l) \hat{\mathbf{n}} = \mu_0 \mathbf{M}$

$\mathbf{b} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_{\text{mag}} = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \mathbf{M}$

Magnetische Erregung: $\mathbf{H} := (1/\mu_0) \mathbf{B} - \mathbf{M}$

$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$

$\oint \mathbf{H} d\mathbf{s} = I_{\text{frei}}$

Magnetische Suszeptibilität: χ_m

Magnetisierung: $\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$

$\mu_0 \mathbf{H} = \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}$

Relative Permeabilität: $\mu = \chi_m + 1$

$\mathbf{B} = \mu_0 \mu \mathbf{H}$

$\chi_m > 0, \mu > 1$: Paramagnetismus

$\chi_m < 0, \mu < 1$: Diamagnetismus

$\chi_m \gg 0, \mu \gg 1$: Ferromagnetismus

Sättigungsmagnetisierung: \mathbf{M}_s

Curie-Gesetz: $\mathbf{M} = \frac{1}{3} \frac{\mu B_{\text{ext}}}{k_B T} \mathbf{M}_s \sim \frac{1}{T}$

Grenzflächen mit unterschiedlichen μ :

$H_{\parallel}^{(1)} = H_{\parallel}^{(2)} \quad \frac{B_{\parallel}^{(1)}}{\mu_1} = \frac{B_{\parallel}^{(2)}}{\mu_2}$

$B_{\perp}^{(1)} = B_{\perp}^{(2)} \quad \mu_1 H_{\perp}^{(1)} = \mu_2 H_{\perp}^{(2)}$

4 Werte

$\epsilon_0 = 8.85416 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

$\mu_0 = \pi \cdot 4 \times 10^{-7} \text{ Vs/Am}$